

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

การทดลองโดยใช้สามทฤษฎีคือ HF MP2 และ DFT ให้ผลการทดลองที่เหมือนกันว่าตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดูดซับของพลาตินั่มอะตอมบนพื้นผิว TiO_2 คือที่ตำแหน่ง O hollow ผลที่ได้นี้มีความสอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้จากกลุ่มการทดลองที่ใช้วิธี simulation อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามผลที่ได้นี้ขัดแย้งกับผลที่ได้จากการทดลองด้วยวิธีการจำลองภาพต่างๆ ซึ่งให้ข้อสรุปว่าตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดคือตำแหน่ง on-top โดยปกติแล้วทอม exchange-correlation function ในวิธี DFT จะเป็นสาเหตุที่มักถูกอ้างถึงเมื่อเกิดความไม่สอดคล้องกับผลการทดลองขึ้น แต่ผลจาก MP2 ในการทดลองนี้กลับให้ผลที่ไปในทิศทางเดียวกัน ความไม่สอดคล้องระหว่างผลที่ได้จากการทดลองและทฤษฎีที่เกิดขึ้นนี้จึงยังคงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไป

ค่า net stabilization energy ของพลาตินั่มคลัสเตอร์บน TiO_2 เป็นค่าที่ได้จากผลรวมของค่าปฏิสัมพันธ์ 3 ค่า คือ ค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลาตินั่มและพลาตินั่มอะตอม ค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลาตินั่มคลัสเตอร์และ TiO_2 และค่าปฏิสัมพันธ์สุดท้ายคือค่าพลังงาน relaxation ซึ่งเกิดขึ้นจากการบิดเบี้ยวไปของโครงสร้างของคลัสเตอร์ซึ่งเกิดจากการดูดซับ ในคลัสเตอร์ที่ถูกเสนอขึ้นในการทดลองนี้คือ Pt_4 (square plana) และ Pt_5 (square pyramidal) ค่าปฏิสัมพันธ์ที่มีผลต่อความเสถียรของการดูดซับมากที่สุดคือแรงดึงดูดระหว่างพลาตินั่มและพลาตินั่มอะตอมด้วยกันเอง ส่วนค่าพลังงานงาน relaxation มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการเกิดเป็นโครงสร้างแบบ 3 มิติของพลาตินั่มน่าจะเกิดจากการชอบเกาะกันเองของพลาตินั่มอะตอมมากกว่าการเกาะกับพื้นผิว TiO_2

เมื่อเกิดการดูดซับของ CO บนโลหะจะเกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากโลหะไปยัง anti-bonding ของโมเลกุล CO ดังอธิบายด้วยแบบจำลองของ Blyholder กระบวนการที่เกิดขึ้นดังกล่าวลดค่าพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลาตินั่มและพื้นผิว TiO_2 ในกรณีของพลาตินั่มอะตอมบน TiO_2 การดูดซับของ CO ทำให้ค่าพลังงานของพันธะ Pt- TiO_2 ลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งการเกิดการดูดซับนี้น่าจะส่งผลให้การเคลื่อนที่ของพลาตินั่มอะตอมบนพื้นผิว TiO_2 เกิดได้ง่ายขึ้น การดูดซับของ CO บนพลาตินั่มคลัสเตอร์ก็ยังคงส่งผลต่อความแข็งแรงของพันธะ Pt- TiO_2 เช่นกันแต่เกิดขึ้นด้วยอัตราที่ต่ำกว่าบนพลาตินั่มอะตอมเป็นอย่างมาก ซึ่งในกรณีนี้ไม่น่าจะทำให้เกิดการหลุดจากพื้นผิวของพลาตินั่มอะตอมหรือ พลาตินั่มคลัสเตอร์ขึ้น นอกจากนี้การดูดซับของ CO บนพลาตินั่มคลัสเตอร์บน TiO_2 น่าจะมีผลทำให้ค่าความเค้นภายในพลาตินั่มคลัสเตอร์ลดลง ซึ่งสิ่งนี้น่าจะช่วยเพิ่มความเสถียรของการเกิดโครงสร้างแบบ monolayer บนพื้นผิว TiO_2

การดูดซับของพลาตินัมคลัสเตอร์บน TiO_2 ส่งผลต่อค่าพลังงานการดูดซับของ CO สำหรับระบบ Pt/TiO_2 การดูดซับของ CO บนพลาตินัมเปลี่ยนไปตามตำแหน่งของพลาตินัมบนพื้นผิว TiO_2 โดยภาพรวม การดูดซับของ CO บนพลาตินัมในสุญญากาศจะมีความเสถียรมากกว่าพลาตินัมที่อยู่บน TiO_2 ปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองของ Blyholder ซึ่งแรงดึงดูดหลักระหว่าง CO และโลหะเกิดขึ้นจากการถ่ายเทอิเล็กตรอนจาก d-band ของโลหะไปยัง π^* orbital ของ CO การถ่ายเทอิเล็กตรอนที่มากก็จะทำให้พันธะนี้แข็งแรง สำหรับพลาตินัมอะตอมบน TiO_2 จะมีประจุเป็นบวกเล็กน้อยปริมาณอิเล็กตรอนที่จะใช้เพื่อสร้างพันธะกับ CO จึงน้อยกว่าพลาตินัมอิสระ สำหรับการดูดซับบนพลาตินัมคลัสเตอร์ซึ่งมีประจุรวมเป็นบวกเล็กน้อยก็ให้ผลเช่นเดียวกัน แต่ในกรณีของพลาตินัมคลัสเตอร์จะมีผลของความเค้นของโครงสร้างของพลาตินัมคลัสเตอร์ร่วมด้วย โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าพลังงานการดูดซับคือผลของความเค้น โดยที่ผลของการถ่ายเทอิเล็กตรอนเนื่องจาก TiO_2 มีผลน้อย สรุปคือการที่พลังงานดูดซับของ CO ลดลงทำให้ CO หลุดออกจากพื้นผิวพลาตินัมได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มความทนต่อความเป็นพิษต่อ CO ของพลาตินัม หรืออีกทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือการที่พลังงานการดูดซับลดลงทำให้ CO เกิดการเคลื่อนที่บนพื้นผิวพลาตินัมได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราเร็วของการเกิด bifunctional mechanism